

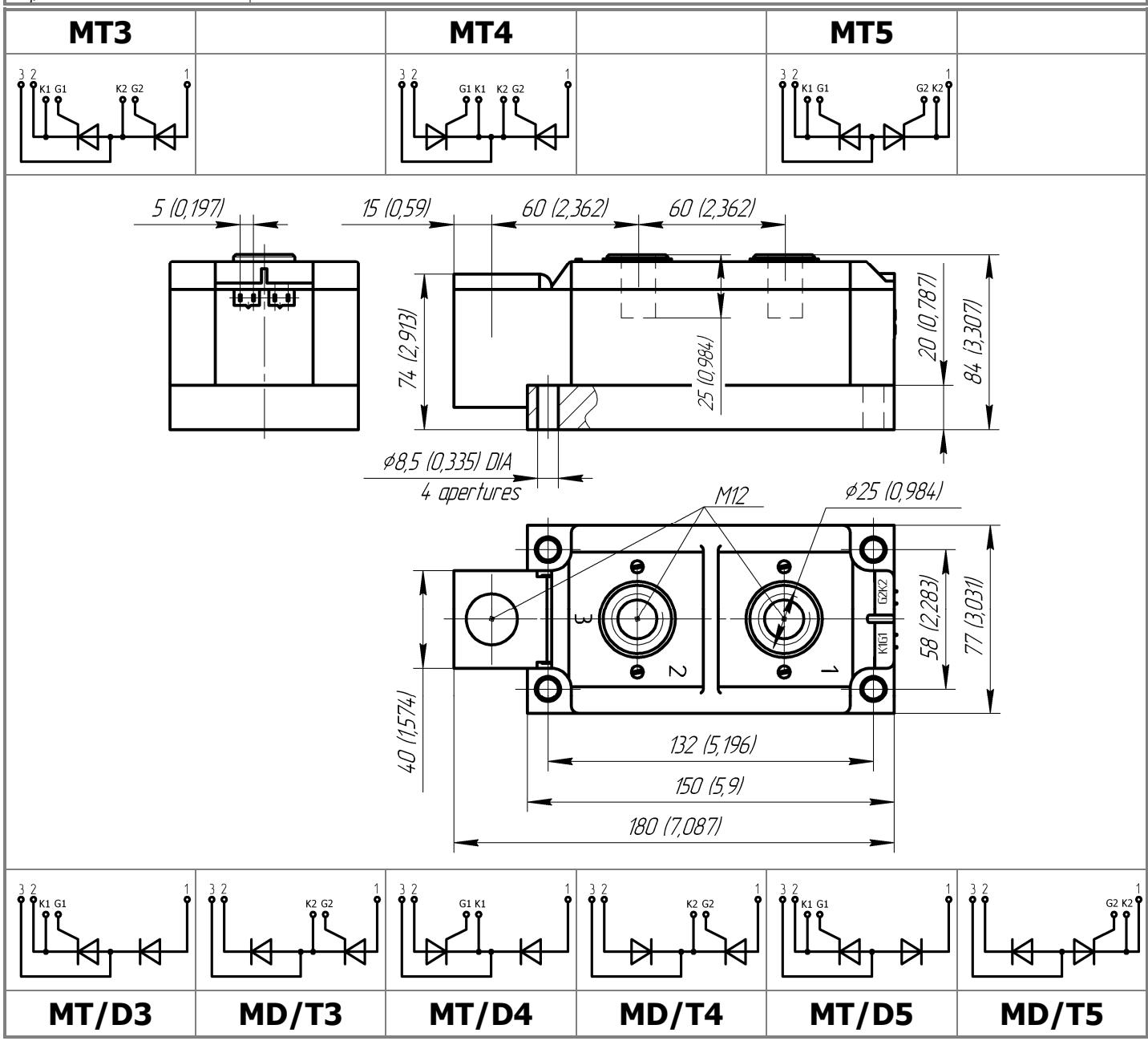


**БиЧип**

Изолированное основание  
Корпус промышленного стандарта  
Упрощенная механическая конструкция,  
быстрая сборка  
Прижимная конструкция

**Двухпозиционный  
Тиристорный Модуль  
МТх-400-44-Д**

Средний прямой ток	I <sub>TAV</sub>	400 A
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U <sub>DRM</sub>	3800 ÷ 4400 В
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U <sub>RRM</sub>	
Время выключения	t <sub>q</sub>	500 мкс
U <sub>DRM</sub> , U <sub>RRM</sub> , В	3800	4000
Класс по напряжению	38	40
T <sub>j</sub> , °C	38	40
	42	44
	– 40 ÷ 125	



Все размеры в миллиметрах (дюймах)

## ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения		
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>						
I <sub>TAV</sub>	Средний ток в открытом состоянии	A	400			
I <sub>TRMS</sub>	Действующий ток в открытом состоянии	A	628		T <sub>c</sub> = 88 °C; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I <sub>TSM</sub>	Ударный ток в открытом состоянии	kA	14.0 16.0	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>D</sub> =U <sub>R</sub> =0 В; Импульс управления: I <sub>G</sub> =2 A; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt≥1 A/мкс	
			15.0 17.0	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>D</sub> =U <sub>R</sub> =0 В; Импульс управления: I <sub>G</sub> =2 A; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt≥1 A/мкс	
I <sup>2</sup> t	Защитный фактор	A <sup>2</sup> c·10 <sup>3</sup>	980 1280	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>D</sub> =U <sub>R</sub> =0 В; Импульс управления: I <sub>G</sub> =2 A; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt≥1 A/мкс	
			930 1195	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>D</sub> =U <sub>R</sub> =0 В; Импульс управления: I <sub>G</sub> =2 A; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt≥1 A/мкс	
<b>Блокирующие параметры</b>						
U <sub>DRM</sub> , U <sub>RRM</sub>	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	V	3800÷4400	T <sub>j min</sub> < T <sub>j </sub> <T <sub>j max</sub> 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто		
U <sub>DSM</sub> , U <sub>RSM</sub>	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	V	3900÷4500	T <sub>j min</sub> < T <sub>j </sub> <T <sub>j max</sub> 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто		
U <sub>D</sub> , U <sub>R</sub>	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	V	0.75·U <sub>DRM</sub> 0.75·U <sub>RRM</sub>	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> управление разомкнуто		
<b>Параметры управления</b>						
I <sub>FGM</sub>	Максимальный прямой ток управления	A	8	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub>		
U <sub>RGM</sub>	Максимальное обратное напряжение управления	V	5			
P <sub>G</sub>	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	4	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> для постоянного тока управления		
<b>Параметры переключения</b>						
(di <sub>T</sub> /dt) <sub>crit</sub>	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии (f=1 Hz)	A/мкс	630	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> ; U <sub>D</sub> =0.67·U <sub>DRM</sub> ; I <sub>TM</sub> =2 I <sub>TAV</sub> ; Импульс управления: I <sub>G</sub> =2 A; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt≥1 A/мкс		
<b>Тепловые параметры</b>						
T <sub>stg</sub>	Температура хранения	°C	-40 ÷ 125			
T <sub>j</sub>	Температура р-п перехода	°C	-40 ÷ 125			
<b>Механические параметры</b>						
a	Ускорение	м/с <sup>2</sup>	50			

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения		
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>						
$U_{TM}$	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	2.70	$T_j=25^\circ C; I_{TM}=2512 A$		
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.20	$T_j=T_{j\max};$ $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$		
$r_T$	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	мОм	0.650			
$I_L$	Ток включения, макс	мА	1500	$T_j=25^\circ C; U_D=12 V;$ Импульс управления: $I_G=2 A;$ $t_{GP}=50 \mu s; di_G/dt \geq 1 A/\mu s$		
$I_H$	Ток удержания, макс	мА	300	$T_j=25^\circ C;$ $U_D=12 V;$ управление разомкнуто		
<b>Блокирующие характеристики</b>						
$I_{DRM}, I_{RRM}$	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	150	$T_j=T_{j\max};$ $U_D=U_{DRM}; U_R=U_{RRM}$		
$(dv_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, мин	В/мкс	1000	$T_j=T_{j\max};$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM};$ управление разомкнуто		
<b>Характеристики управления</b>						
$U_{GT}$	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	5.00 3.00 2.00	$T_j = T_{j\min}$ $T_j=25^\circ C$ $T_j = T_{j\max}$	$U_D=12 V; I_D=3 A;$ Постоянный ток управления	
$I_{GT}$	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	500 300 200	$T_j = T_{j\min}$ $T_j=25^\circ C$ $T_j = T_{j\max}$		
$U_{GD}$	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.35	$T_j = T_{j\max};$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM};$	Постоянный ток управления	
$I_{GD}$	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	15.00	Постоянный ток управления		
<b>Динамические характеристики</b>						
$t_{gd}$	Время задержки включения	мкс	3.50	$T_j=25^\circ C; V_D=0.4 \cdot U_{DRM}; I_{TM}=I_{TAV};$ Импульс управления: $I_G=2 A;$ $t_{GP}=50 \mu s; di_G/dt \geq 1 A/\mu s$		
$t_q$	Время выключения, макс	мкс	500	$dv_D/dt=50 V/\mu s; T_j=T_{j\max}; I_{TM}=I_{TAV};$ $di_R/dt=-10 A/\mu s; U_R=100 V;$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM};$		
<b>Тепловые характеристики</b>						
$R_{thjc}$	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс			180 эл. град. синус; 50 Гц ( $t_p=10 \mu s$ )		
	на модуль	°C/Вт	0.0250			
	на позицию	°C/Вт	0.0500			
$R_{thch}$	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс					
	на модуль	°C/Вт	0.0080			
	на позицию	°C/Вт	0.0160			
<b>Характеристики изоляции</b>						
$U_{ISOL}$	Электрическая прочность изоляции	кВ	3.00	синус; 50 Гц; действующее значение		
			3.60	$t=1 \text{ мин}$		
<b>Механические характеристики</b>						
$M_1$	Момент затяжки основания (M8) <sup>1)</sup>	Нм	9.00	Допуск $\pm 15\%$		
$M_2$	Момент затяжки выводов (M12) <sup>1)</sup>	Нм	18.00	Допуск $\pm 10\%$		
$w$	Масса, тип	г	4000			

МАРКИРОВКА	ПРИМЕЧАНИЕ																				
<table border="1" data-bbox="96 137 790 213"> <tr> <td>МТ</td><td>3</td><td>-</td><td>400</td><td>-</td><td>44</td><td>-</td><td>D</td><td>-</td><td>УХЛ2</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td><td>4</td><td></td><td>5</td><td></td><td>6</td> </tr> </table> <p>         1. Тиристорный модуль (МТ)          Тиристорно-диодный модуль (МТ/Д)          Диодно-тиристорный модуль (МД/Т)          2. Схема включения          3. Средний прямой ток, А          4. Класс по напряжению          5. Тип корпуса (M.D)          6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2       </p>	МТ	3	-	400	-	44	-	D	-	УХЛ2	1	2		3		4		5		6	<p>1) Резьба должна быть смазана</p>
МТ	3	-	400	-	44	-	D	-	УХЛ2												
1	2		3		4		5		6												